

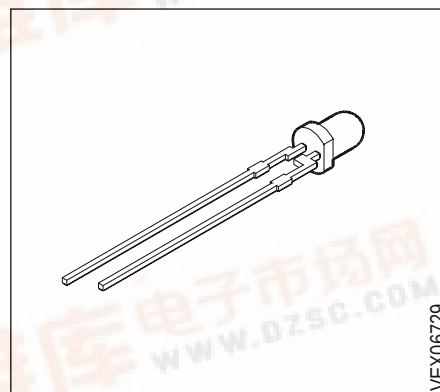
SIEMENS

3 mm (T1) MULTILED®, Diffused

LSG 3351

Besondere Merkmale

- nicht eingefärbtes, diffuses Gehäuse
- antiparallel geschaltete Leuchtdiodenchips
- hohe Signalwirkung durch Farbwechsel der LED möglich
- bei geeigneter Ansteuerung mit IC (z.B. SDA 2231), Farbwechsel von grün über gelb und orange bis super-rot möglich
- beide Farben getrennt ansteuerbar
- gegurtet lieferbar
- Störimpulsfest nach DIN 40839



Features

- colorless, diffused package
- antiparallel chips
- high signal efficiency possible by color change of the LED
- with appropriate controlling by IC (e.g. SDA 2231) it is possible to change color from green to yellow, orange and super-red
- both colors can be controlled separately
- available taped on reel
- load dump resistant acc. to DIN 40839

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Gehäusefarbe Color of Package	Lichtstärke Luminous Intensity $I_F = 10 \text{ mA}$ $I_V \text{ (mcd)}$	Bestellnummer Ordering Code
LSG 3351-HO	super-red / green	colorless diffused	$\geq 2.5 \text{ (10 typ.)}$	Q62703-Q2297

Streuung der Lichtstärke in einer Verpackungseinheit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0^{1)}$

Streuung der Lichtstärke in einer LED $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 3.0$.

1) Bei MULTILED® bestimmt die Helligkeit des jeweils dunkleren Chips in einem Gehäuse die Helligkeitsgruppe der LED.

Luminous intensity ratio in one packaging unit $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 2.0^{1)}$

Luminous intensity ratio in one LED $I_{V \max} / I_{V \min} \leq 3.0$.

1) In case of MULTILED®, the brightness of the darker chip in one package determines the brightness group of the LED.

Grenzwerte¹⁾ Maximum Ratings¹⁾

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Betriebstemperatur Operating temperature range	T_{op}	– 55 ... + 100	°C
Lagertemperatur Storage temperature range	T_{stg}	– 55 ... + 100	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	+ 100	°C
Durchlaßstrom Forward current	I_F	40	mA
Stoßstrom Surge current $t \leq 10 \mu s, D = 0.005$	I_{FM}	0.5	A
Verlustleistung Power dissipation $T_A \leq 25 \text{ °C}$	P_{tot}	140	mW
Wärmewiderstand Thermal resistance Sperrschicht / Luft Junction / air	$R_{th JA}$	400	K/W

¹⁾ Die angegebenen Grenzdaten gelten für den Chip, für den sie angegeben sind, unabhängig vom Betriebszustand des anderen.

¹⁾ The stated maximum ratings refer to the specified chip regardless of the other one's operating status.

Kennwerte ($T_A = 25\text{ °C}$)

Characteristics

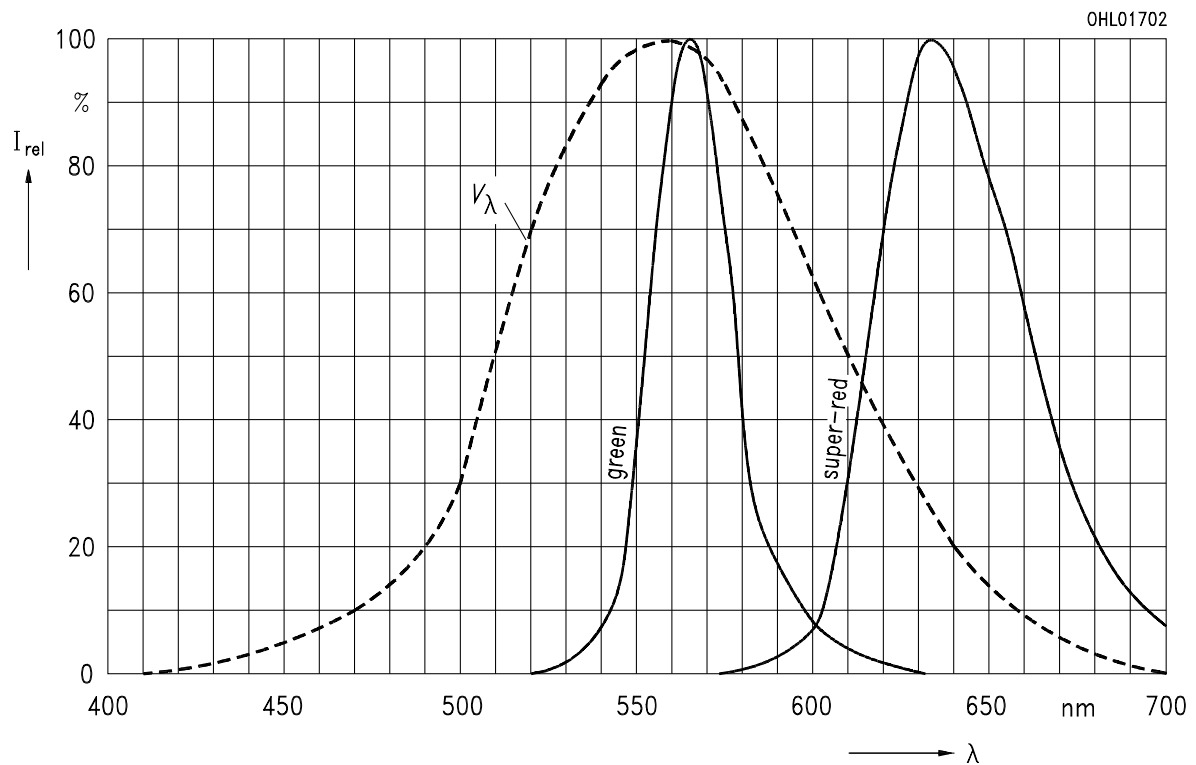
Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		super-red	green	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission (typ.) $I_F = 20\text{ mA}$	λ_{peak}	635	565	nm
Dominantwellenlänge (typ.) Dominant wavelength (typ.) $I_F = 20\text{ mA}$	λ_{dom}	628	570	nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) Spectral bandwidth at 50 % $I_{\text{rel max}}$ (typ.) $I_F = 20\text{ mA}$	$\Delta\lambda$	45	25	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % I_V (Vollwinkel) Viewing angle at 50 % I_V	2ϕ	50	50	Grad deg.
Durchlaßspannung (typ.) Forward voltage (max.) $I_F = 10\text{ mA}$	V_F V_F	2.0 2.6	2.0 2.6	V V
Kapazität (typ.) Capacitance $V_R = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$	C_0	27		pF
Schaltzeiten: Switching times: I_V from 10 % to 90 % (typ.) I_V from 90 % to 10 % (typ.) $I_F = 100\text{ mA}$, $t_p = 10\text{ }\mu\text{s}$, $R_L = 50\text{ }\Omega$	t_r t_f	300 150	450 200	ns ns

Relative spektrale Emission $I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_A = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 20\text{ mA}$

Relative spectral emission

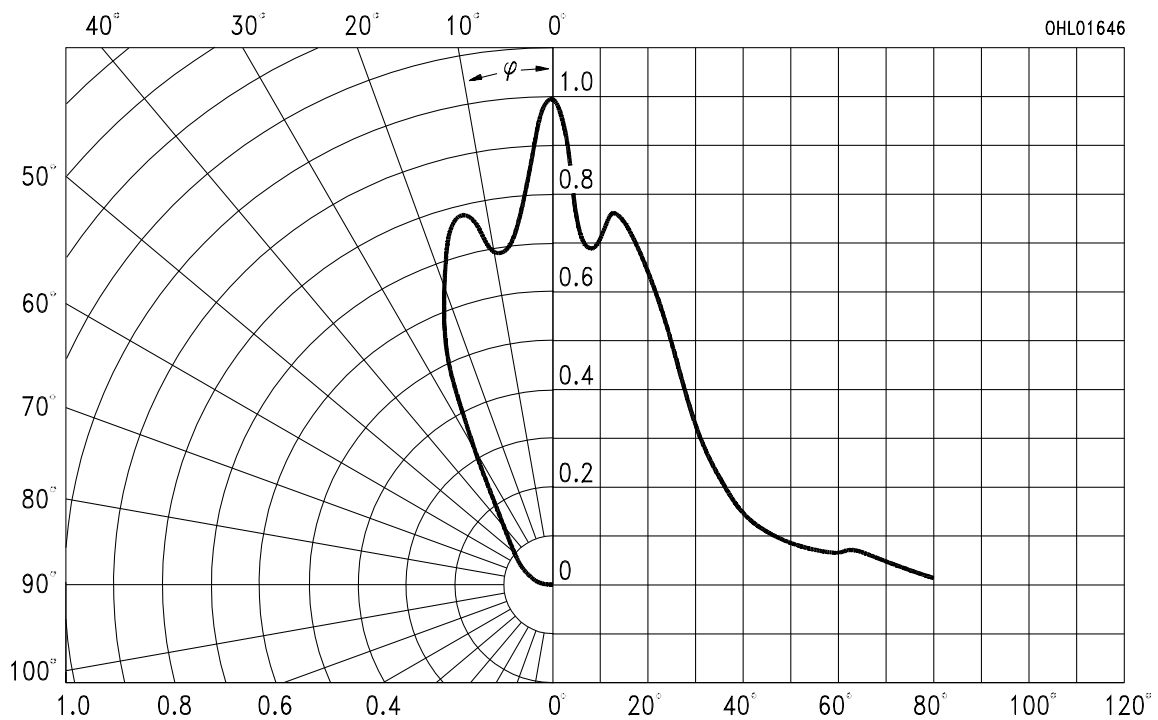
$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit

Standard eye response curve



Abstrahlcharakteristik $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$

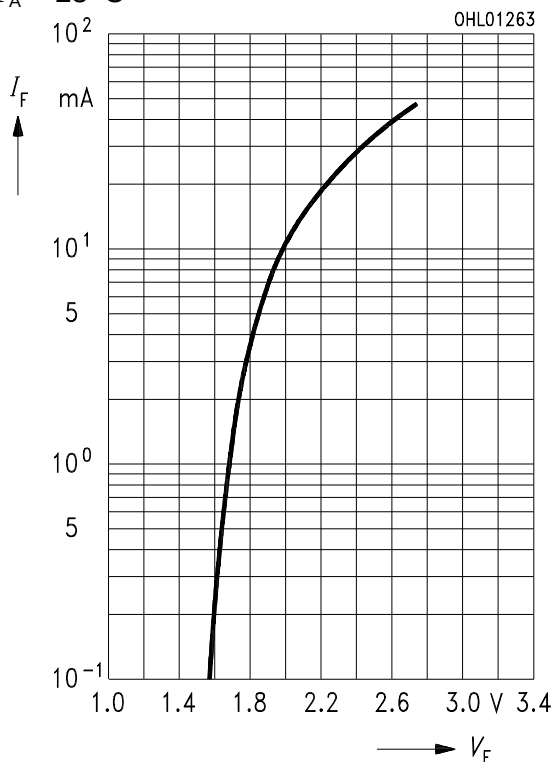
Radiation characteristic



Durchlaßstrom $I_F = f(V_F)$

Forward current

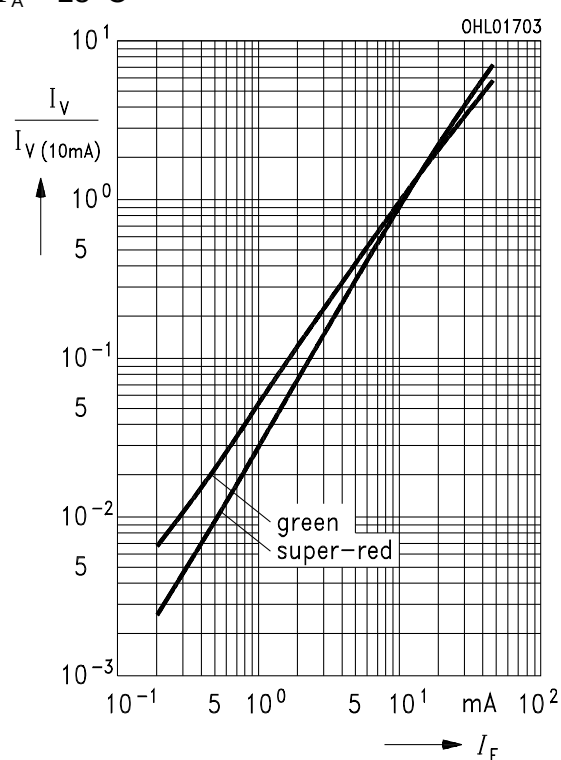
$T_A = 25^\circ\text{C}$



Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(10\text{ mA})} = f(I_F)$

Relative luminous intensity

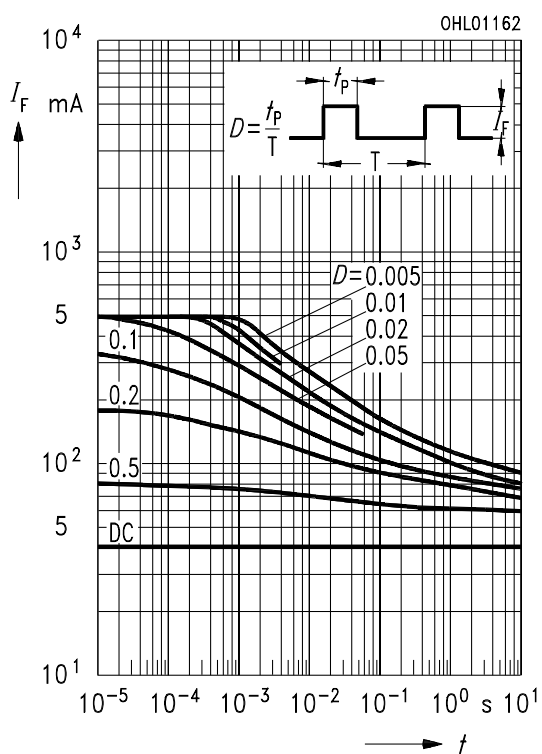
$T_A = 25^\circ\text{C}$



Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_P)$

Permissible pulse handling capability

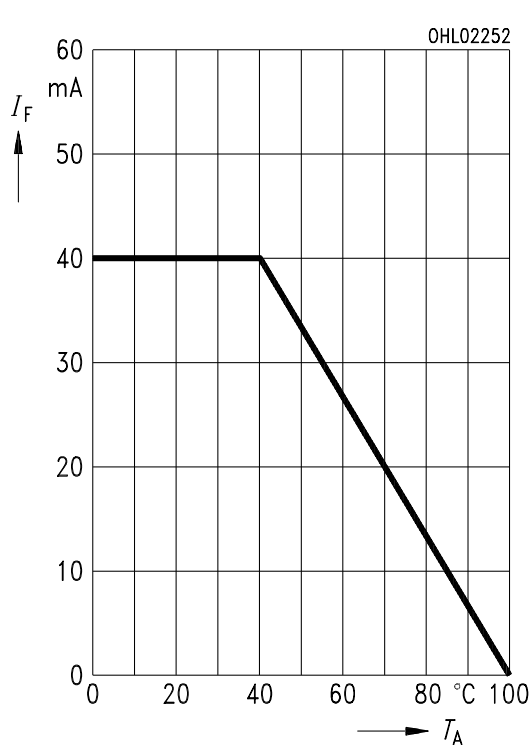
Duty cycle $D = \text{parameter}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



Maximal zulässiger Durchlaßstrom

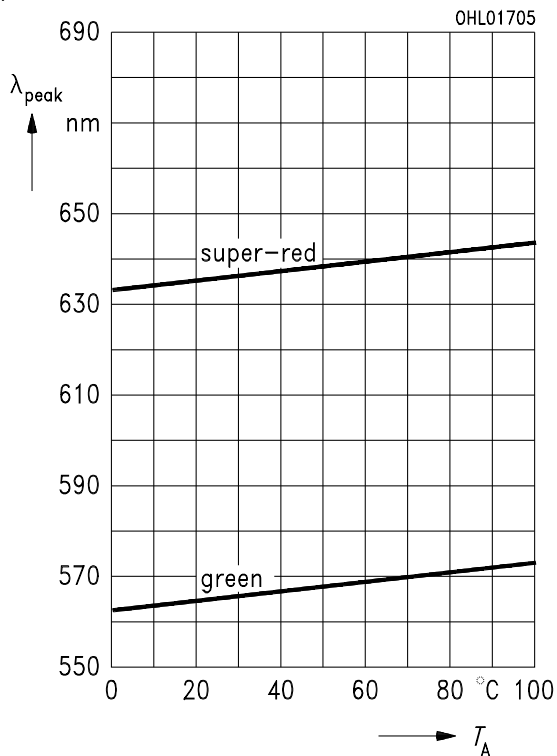
Max. permissible forward current

$I_F = f(T_A)$



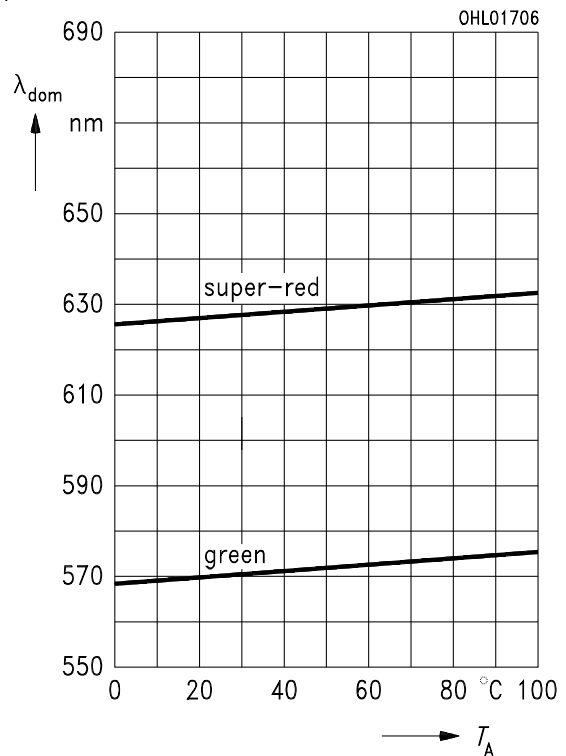
Wellenlänge der Strahlung $\lambda_{\text{peak}} = f(T_A)$ Wavelength at peak emission

$I_F = 20 \text{ mA}$



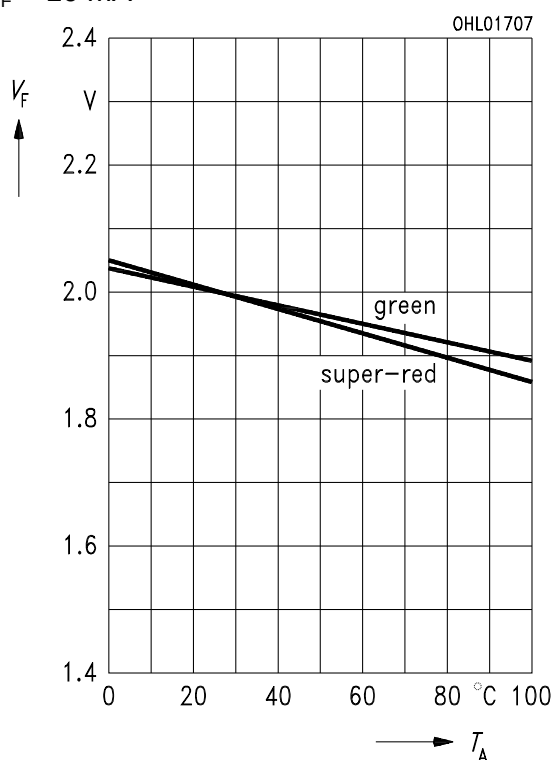
Dominantwellenlänge $\lambda_{\text{dom}} = f(T_A)$ Dominant wavelength

$I_F = 20 \text{ mA}$



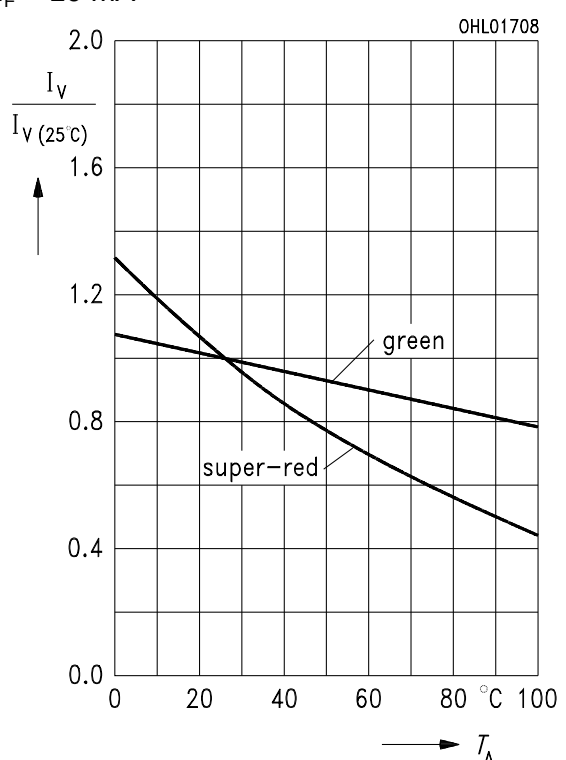
Durchlaßspannung $V_F = f(T_A)$ Forward voltage

$I_F = 10 \text{ mA}$

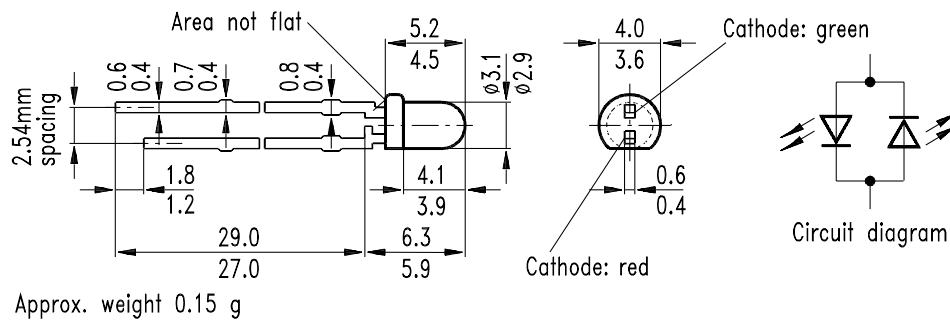


Relative Lichtstärke $I_V/I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_A)$ Relative luminous intensity

$I_F = 10 \text{ mA}$



Maßzeichnung (Maße in mm, wenn nicht anders angegeben)
Package Outlines (Dimensions in mm, unless otherwise specified)



GEX06729

Kathodenkennzeichnung:

grün: längerer Lötspieß
 rot: kürzerer Lötspieß

Cathode mark:

green: long solder lead
 red: short solder lead